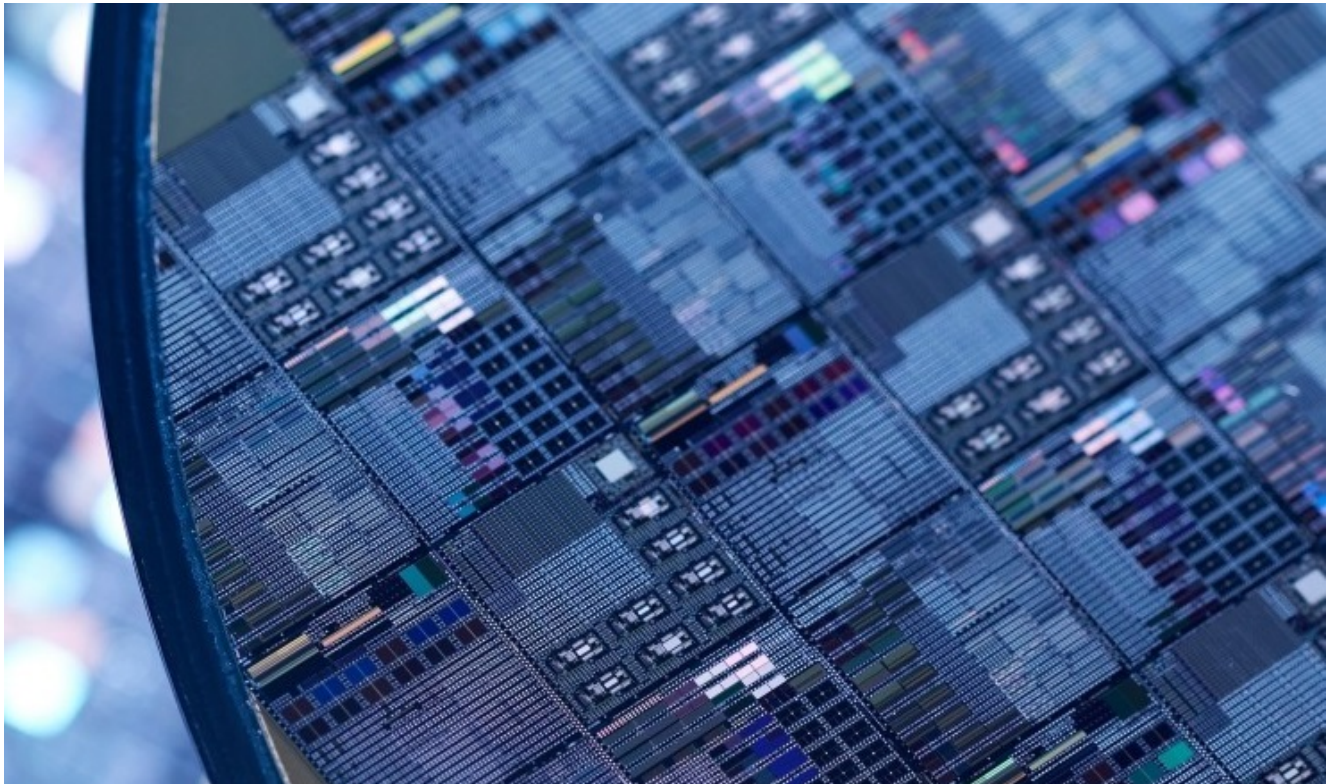


Samsung comenzará en breve a producir chips a 5 nm, avanza en el desarrollo de los 3 nm GAAFET



Samsung sigue su pulso de desarrollo de procesos litográficos con TSMC, y ahora ha querido dejar claro el estado de su desarrollo.

La compañía ha indicado que en este trimestre va a comenzar la producción en masa de chips con su proceso de 5 nm que hace un amplio uso de luz ultravioleta extrema (UVE) para crear una mayor cantidad de capas que en procesos anteriores. Esto acelera la producción de las obleas pero también reduce la complejidad del proceso de producción.

La compañía espera ampliar su liderazgo en la fabricación de chips usando tecnología de luz UVE, aunque no ha descartado

que la situación de pandemia por la covid-19 haya introducido ciertas incertidumbres en la producción. Tras el comienzo de la producción en masa de chips a 5 nm la compañía redoblará esfuerzos en el desarrollo de su nodo litográfico de 3 nm, el cual usará un nuevo tipo de transistores denominado GAAFET (transistor de efecto de campo de puerta amplia).

Lo que viene a hacer ese nuevo tipo de FET es pasar a disponer de cuatro puertas por canal común haciendo uso de nanotubos en lugar de aletas incrustadas en la puerta, mejorando la densidad de los chips y reduciendo el consumo.

Fuente: TechPowerUp.